
	<p>SI4164DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4164DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4164DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21393 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4164DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21393 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 30A (Tc) 3W (Ta), 6W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3545pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4164DY-T1-GE3TR

SI4164DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4164DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4164DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4164DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4166DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4166DY-T1-E3 VISHAY SI4166DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4162DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 19.3A 8-SOIC</p>	 <p>SI4166DY-T1 VISHAY VISHAY SO-8</p>
 <p>SI4166DY SI SI4166DY SI</p>	 <p>SI4162DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 19.3A 8-SOIC</p>	 <p>SI4164DY SI SI4164DY SI</p>	 <p>SI4164DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

SI4134T-GMR	SI4136-F-GM	SI4136-F-GMR	SI4136DY-T1-GE3	SI4136DY-T1-GE3
SI4136XM-BT	SI4136XM-GTR	SI4154DY-T1-GE3	SI4154DY-T1-GE3	SI4156DY
SI4156DY-T1-E3	SI4156DY-T1-GE3	SI4156DY-T1-GE3	SI4160DY	SI4160DY-T1-E3
SI4160DY-T1-GE3	SI4160DY-T1-GE3	SI4160DY-TI-GE3	SI4162DY	SI4162DY-T1-E3
SI4162DY-T1-GE3	SI4162DY-T1-GE3	SI4164DY	SI4164DY-T1-E3	SI4164DY-T1-GE3
SI4166DY	SI4166DY-T1-E3	SI4166DY-T1-GE3	SI4166DY-T1-GE3	SI4168DY
SI4168DY-T1-E3	SI4168DY-T1-GE3	SI4168DY-T1-GE3	SI4170DY-T1-GE3	SI4170DY-T1-GE3
SI4172DY	SI4172DY-T1-E3	SI4172DY-T1-GE3	SI4172DY-T1-GE3	SI4174DY
SI4174DY-T1-E3	SI4174DY-T1-GE3	SI4174DY-T1-GE3	SI4176DY-T1-GE3	SI4176DY-T1-GE3
SI4178DY	SI4178DY-T1-E3	SI4178DY-T1-E3	SI4178DY-T1-GE3	SI4178DY-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

